

Analysis of deep level centers in GaAs pin-diode structures Korolkov, Oleg; Toompuu, Jana; Rang, Toomas *Elektronika ir elektrotehnika = Electronics and electrical engineering* 2013 / [4 p.] : ill

Analysis of deep level spectrum in GaAs p⁺-p-i-n-n⁺ structures Toompuu, Jana; Sleptšuk, Natalja; Korolkov, Oleg; Rang, Toomas *Materials characterization VII* 2015 / p. 283-294 : ill

Characterization of deep level traps in semiconductor structures using numerical experiments Koel, Ants; Rang, Toomas; Rang, Galina *Materials characterization VII* 2015 / p. 253-261 : ill

Characterization of Interfaces Between the Metal Film and Silicon Carbide Semiconductor = Metallkontakti ja ränikarbiidi vahelise liidespinna karakteriseerimine Ziko, Mehadi Hasan 2021 <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/34be534c-63e8-4013-b271-eaf1a7cb22e7>
https://www.ester.ee/record=b5471196*est

Comparative characteristics of diffusion-welded high-voltage stacks and connected in series Schottky diodes Sleptšuk, Natalja; Korolkov, Oleg; Land, Raul; Toompuu, Jana; Annus, Paul; Rang, Toomas *BEC 2016 : 2016 15th Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 15th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology, October 3-5, 2016, Tallinn, Estonia* 2016 / p. 39-42 : ill http://www.ester.ee/record=b2150914*est

Degradation of 600-V 4H-SiC Schottky diodes under irradiation with 0.9 MeV electrons Lebedev, Alexander A.; Davidovskaja, Klavdia; Kozlovski, Vitali V.; Korolkov, Oleg; Sleptšuk, Natalja; Toompuu, Jana *Silicon Carbide and Related Materials 2016 : selected, peer reviewed papers from the 11th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2016 (ECSCRM 2016), September 25-29, 2016, Halkidiki, Greece* 2017 / p. 447-450 : ill <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.897.447>

Formation of Diffusion welded Al contacts to semiconductor silicon carbide Korolkov, Oleg 2004

High voltage diffusion welded stacks on the basis of SiC Schottky diodes Korolkov, Oleg; Rang, Toomas; Sleptšuk, Natalja; Annus, Paul; Land, Raul *ICSRM 2015 : program guide* 2015 / p. 73

High-voltage diffusion welded stacks on the basis of SiC Schottky diodes Korolkov, Oleg; Sleptšuk, Natalja; Annus, Paul; Land, Raul; Rang, Toomas *Silicon carbide and related materials 2015 (ICSRM 2015) : selected, peer reviewed papers from the 16th International Conference on Silicon Carbide and Related Materials, October 4-9, 2015, Giardini Naxos, Italy* 2016 / p. 790-794 : ill <http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.858.790>

Investigation of deep level centers in i- and n-layers of GaAs pin-diodes Toompuu, Jana; Korolkov, Oleg; Sleptšuk, Natalja; Rang, Toomas *BEC 2014 : 2014 14th Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 14th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology, October 6-8, 2014, Tallinn, Estonia* 2014 / p. 25-28 : ill

Investigation of electrical characteristics of SiC based complementary JBS structures Kurel, Raido 2005 https://www.ester.ee/record=b2053292*est

Investigation of the intermediate layer in the metal-silicon carbide contact obtained by diffusion welding = Difusioonkeevitusega valmistatud metalli ja ränikarbiidi vahelise üleminekuala vahekihi uurimine Sleptšuk, Natalja 2011 https://www.ester.ee/record=b2692547*est

Method of samples preparation intended for research of deep centers in i-, n-, and p-layers of GaAs p⁺-pin-n⁺ structures and result of analysis Toompuu, Jana; Sleptšuk, Natalja; Korolkov, Oleg; Rang, Toomas *BEC 2016 : 2016 15th Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 15th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology, October 3-5, 2016, Tallinn, Estonia* 2016 / p. 35-38 : ill http://www.ester.ee/record=b2150914*est

Numerical analysis of forward-biased diode structures based on direct-gap semiconductors Velmre, Enn; Freidin, Boris *Electronics letters : an international publication* 1979 / p. 383-385 https://www.ester.ee/record=b2180432*est

Numerical analysis of the on state of diode structures based on direct-gap semiconductors Velmre, Enn; Freidin, Boris; Udal, Andres *Physica scripta : an international journal for experimental and theoretical physics* 1981 / p. 468-471 https://www.ester.ee/record=b2244094*est

Numerical modeling of the electrothermal transient process in diode structures based on direct-gap semiconductors Velmre, Enn; Freidin, Boris *Physica status solidi. A, Applied research* 1983 / p. K131-K134 https://www.ester.ee/record=b1562026*est

Power diode transient characteristics modeling in inductive load circuits Freidin, Boris; Velmre, Enn; Udal, Andres *The Bug Exterminator (USA)* 1991 / 3, p. 1-5: fig

SiC JBS diode symmetrical voltage doubler represented as the diffusion-welded stack Korolkov, Oleg; Land, Raul; Toompuu, Jana; Sleptšuk, Natalja; Rang, Toomas *Silicon carbide and related materials 2017 : ICSCRM 2017 : selected, peer reviewed papers from the 2017 International Conference on Silicon Carbide and related materials, September 17-22, 2017, Washington, DC, USA* 2018 / p. 862-865 : ill <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.924.862>

SIC schottky diode rectifier bridge represented as the diffusion-welded stack Korolkov, Oleg; Kozlovski, Vitali V.; Lebedev, Alexander A.; Land, Raul; Sleptšuk, Natalja; Toompuu, Jana; Rang, Toomas Silicon Carbide and Related Materials 2016 : selected, peer reviewed papers from the 11th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2016 (ECSCRM 2016), September 25-29, 2016, Halkidiki, Greece 2017 / p. 697-700 : [illhttps://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.897.697](https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.897.697)

SIC schottky diode rectifier bridge represented as the diffusion-welded stack Korolkov, Oleg; Land, Raul; Sleptšuk, Natalja; Toompuu, Jana; Rang, Toomas 11th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials : September 25-29, 2016, Porto Carras Grand Resort, Halkidiki, Greece : [poster session] 2016 / p. 42

Влияние распределения примеси на прямую ВАХ арсенидгаллиевых силовых диодных структур Velmre, Enn; Freidin, Boris Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 32-37 https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Высоковольтный диод серии B9 Vaher, G.; Vergi, U.; Karuks, O.; Kuusik, E.; Krunks, O.; Tarma, M.; Tarma, Mati Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 11978 / с. 5-12 https://www.ester.ee/record=b1273235*est

Интегральное использование силового запираемого тиристора со встречно-параллельно включенным диодом Pikkov, Mihhail; Saks, P.; Seleninov, Kazimir Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 45 https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Исследование и разработка приборов интегрального исполнения системы тиристор-диод Krunks, O.; Seleninov, K.; Tarma, Mati Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1981 / с. 30-34 https://www.ester.ee/record=b1264428*est

Исследование прямой ВАХ мощных диодов с узкой базовой областью Vaher, G.; Velmre, Enn; Tarma, Mati Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 9-12 https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Исследование прямой ветви вольт-амперной характеристики эпитаксиальных и диффузионных электросварочных диодов Vaher, G.; Velmre, Enn; Mäe, T.; Freidin, Boris Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1981 / с. 7-15 https://www.ester.ee/record=b1264428*est

Моделирование на ЭЦВМ физических процессов в полупроводниковых диодах бомбардируемых электронным лучом Suškov, Aleksandr; Freidin, Boris Автоматизированное проектирование в радиоэлектронике и приборостроении : сборник научных трудов 1977 / с. 155-156 https://www.ester.ee/record=b2065276*est

Неизотермическая динамическая прямая ветвь вольт-амперной характеристики силовых арсенид-галлиевых диодов Aškinazi, German; Velmre, Enn; Logussov, A.; Timofejev, V.; Freidin, Boris; Šumilin, V. Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии наук Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics 1984 / с. 48-56 https://www.ester.ee/record=b1264310*est

Низковольтные диоды на большие токи с эпитаксиальной базовой областью Vaher, G.; Karuks, O.; Mäe, T.; Tarma, M.; Tarma, Mati Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1981 / с. 23-29 https://www.ester.ee/record=b1264428*est

Низковольтный диод для электросварки и гальваники с эпитаксиальной базовой областью Vaher, G.; Tarma, M.; Tarma, Mati Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 11978 / с. 50-62 https://www.ester.ee/record=b1273235*est

О возможности улучшения прямой ВАХ высоковольтного диода Vaher, G.; Krunks, O.; Kuusik, E.; Tarma, M.; Tarma, Mati Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 11978 / с. 13-20 https://www.ester.ee/record=b1273235*est

О целесообразности увеличения обратного напряжения силовых кремниевых диодов Vaher, G.; Tarma, Mati Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 11978 / с. 21-24 https://www.ester.ee/record=b1273235*est

Определение характеристик силовых диодных структур методом фотохронографии рекомбинационного излучения Kruusing, Arvi; Udal, Andres; Vaher, G. Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей. Часть II 1989 / с. 129-133 https://www.ester.ee/record=b1264433*est

Приближенная теория для расчета характеристик обратного восстановления высоковольтных диффузионных диодов в индуктивных цепях Udal, Andres Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1986 / с. 54-58 : [илhttps://www.ester.ee/record=b1591355*est](https://www.ester.ee/record=b1591355*est)

Разработка и освоение производства серии мощных тиристор-диодов Seleninov, Kazimir; Tarma, M.; Krunks, O.; Tarma, Mati Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1986 / с. 161-167 : [илhttps://www.ester.ee/record=b1591355*est](https://www.ester.ee/record=b1591355*est)

Сборник терминов по силовым диодам и тиристорам на английском, немецком и русском языках = Terms of power diodes and thyristors in English, German and Russian = Fachausdrücke für Leistungsdioden und -Thyristoren in englisch, deutsch und russisch 1979 https://www.ester.ee/record=b1267518*est

Сравнение статических параметров диодных структур из GaAs и InP Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boris Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 30-31 https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Усовершенствование технологии и конструкции диодов Д143-2000 с применением диффузионной сварки Vaher, G.; Karuks, O.; Kruus, J.; Surženkov, G.; Tarma, M.; Tarma, Mati Технология силовых полупроводниковых приборов : сборник статей 1987 / с. 134-138 : ил., табл. https://www.ester.ee/record=b1353933*est

Численное моделирование неизотермических переходных процессов в арсенид-галлиевых диодных структурах Velmre, Enn; Freidin, Boris Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-технический журнал. Радиоэлектроника 1984 / с. 86-88 https://www.ester.ee/record=b2768571*est

Численное моделирование переходных процессов в арсенид-галлиевых диодных структурах Velmre, Enn; Freidin, Boris Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-технический журнал. Радиоэлектроника 1983 / с. 93-95 https://www.ester.ee/record=b2768571*est

Численное моделирование процессов включения и выключения диодной структуры на основе прямозонного полупроводника Velmre, Enn; Freidin, Boris Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей 1984 / с. 90-94 https://www.ester.ee/record=b1238033*est

Численное моделирование статических неизотермических процессов в кремниевых силовых диодных и тиристорных структурах в открытом состоянии Velmre, Enn; Udal, Andres; Freidin, Boris Всесоюзный научно-технический семинар "Повышение параметров силовых полупроводниковых приборов на основе новых конструктивных решений и методов изготовления" (Запорожье, 1981) 1981 / с. 37-38

Численное моделирование физических процессов в одномерных кремниевых диодных структурах в стационарном режиме Velmre, Enn; Freidin, Boris; Udal, Andres Алгоритмы и программы : информационный бюллетень 1980 / с. ?

Численный анализ неизотермических переходных процессов в арсенидгаллиевых диодных структурах Aškinazi, German; Velmre, Enn; Kivi, U.; Timofejev, V.; Freidin, Boris; Šumilin, V. Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы докладов II республиканской конференции, Эльва 24-26 ноября 1982 г. 1982 / с. 15 https://www.ester.ee/record=b1304403*est

Численный анализ переходных процессов в диодных структурах на основе прямозонных полупроводников Velmre, Enn; Freidin, Boris Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы докладов II республиканской конференции, Эльва 24-26 ноября 1982 г. 1982 / с. 26 https://www.ester.ee/record=b1304403*est